

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

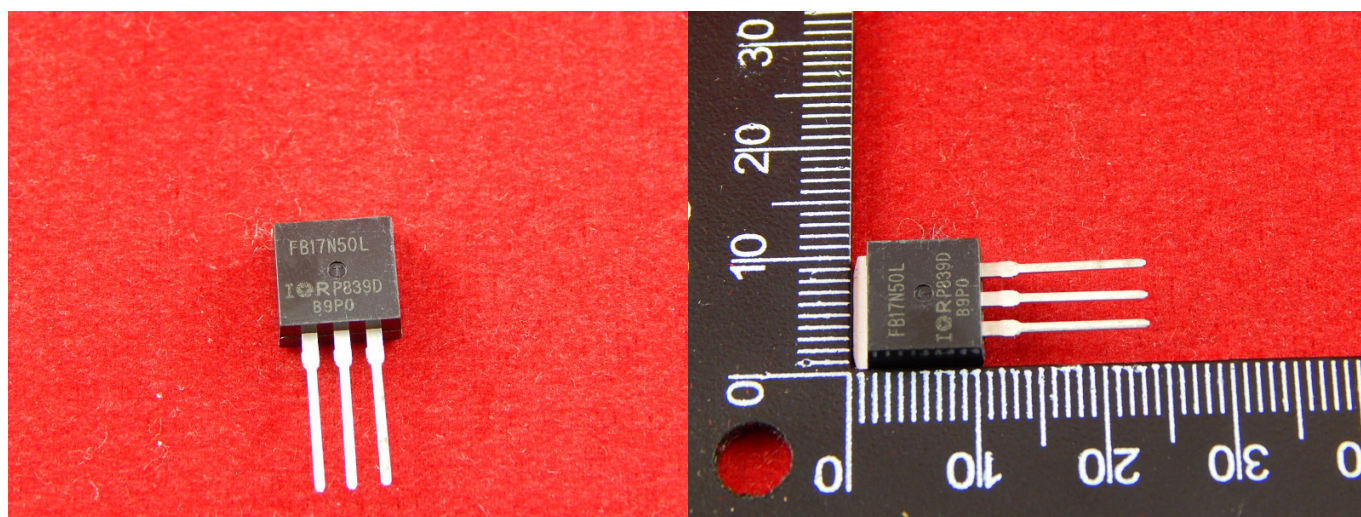
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15275

Цена в прайсе: 870 тг.

IRFB17N50L полевой транзистор, N



Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

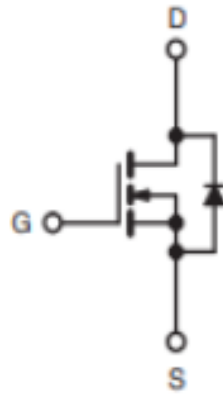
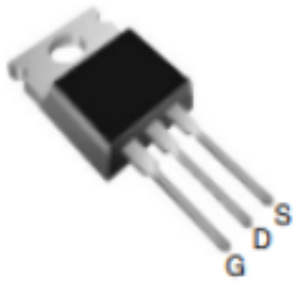
Транзистор - полупроводниковый элемент с тремя выводами, на один из которых подаётся сильный ток, а на другой подаётся слабый управляющий ток.

Спецификация:

- Наименование прибора: IRFB17N50L;
- Тип транзистора: MOSFET;
- Полярность: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 220 W;
- Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 500 V;
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 30 V;
- Пороговое напряжение включения Ugs(th): 5 V;
- Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 16 A;
- Максимальная температура канала (Tj): 150 °C;
- Общий заряд затвора (Qg): 130 nC;
- Время нарастания (tr): 51 ns;
- Выходная емкость (Cd): 325 pf;
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.32 Ohm;
- Тип корпуса: TO-220AB.

Подключение:

TO-220AB



N-Channel MOSFET